

Cesta De Limpieza Personalizada De Ptfе Para Obleas Semiconductores, Resistente A La Corrosión, Bajo Fondo De Interferencia, Rack De Laboratorio

Número de artículo: PL-CP267



Introducción

Logre una pureza superior en la fabricación de semiconductores con nuestras cestas de limpieza de PTFE personalizadas. Diseñadas para una resistencia química extrema y una baja interferencia de fondo, estos racks duraderos garantizan un procesamiento eficiente de obleas, un drenaje rápido y un rendimiento confiable en entornos críticos de laboratorio de alta pureza.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Proceso de Limpieza RCA	Utilizado durante las secuencias SC-1 y SC-2 para eliminar residuos orgánicos y contaminantes metálicos de las obleas de silicio.	Previene la recontaminación debido a la superficie del material ultra puro y de baja lixiviación.
Grabado con Piranha	Manejo de obleas en una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno para la eliminación de fotoresina.	Resistencia excepcional a entornos oxidativos agresivos sin degradación estructural.
Inmersión en Ácido Fluorhídrico	Eliminación de capas de óxido nativo de sustratos de silicio utilizando soluciones de HF concentradas o amortiguadas.	Inmunidad total al ataque del HF, asegurando la supervivencia a largo plazo del equipo y la pureza del proceso.
Enjuague Post-CMP	Limpieza de obleas después del Pulido Químico Mecánico para eliminar partículas de la suspensión y productos químicos.	El drenaje rápido y las propiedades antiadherentes evitan que las partículas de la suspensión se adhieran a la cesta.
Revelado en Fotolitografía	Soporte de sustratos durante el revelado y eliminación de capas de fotoresina.	La alta estabilidad dimensional garantiza un alineamiento y manejo precisos durante los pasos críticos de litografía.
Preparación para Análisis de Trazas	Limpieza de material de laboratorio y contenedores utilizados en ICP-MS y otras técnicas analíticas de alta sensibilidad.	Los niveles de fondo extremadamente bajos garantizan la máxima precisión en la detección de impurezas metálicas traza.
Procesamiento de Obleas de GaAs	Manejo de obleas de semiconductores compuestos a través de ciclos especializados de grabado y enjuague.	Las estructuras de soporte suaves previenen la rotura de los materiales de semiconductores compuestos frágiles.
Limpieza Ultrasónica	Funcionando como un portador sumergido durante ciclos de limpieza acústica de alta frecuencia.	Transmite eficientemente la energía ultrasónica mientras protege las obleas del contacto mecánico con el tanque.

Característica	Detalles de Especificación para PL-CP267
Identificador del Modelo	PL-CP267
Material Principal	PTFE Virgen de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)
Proceso de Fabricación	100% Mecanizado CNC de Precisión (Sin residuos de moldeo por inyección)
Resistencia Química	Resistencia completa a HF, H2SO4, HNO3, HCl, KOH y Disolventes Orgánicos
Rango de Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Acabado Superficial	Acabado liso, de baja porosidad para minimizar la retención de partículas

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Característica	Detalles de Especificación para PL-CP267	
Opciones de Configuración	Totalmente Personalizable (Tamaño de oblea, ancho de ranura, paso de ranura, diseño del asa)	
Compatibilidad con Obleas	Adecuado para obleas de 2", 3", 4", 6", 8" y 12" o dimensiones personalizadas	
Diseño de Drenaje	Perfiles de ranura con fondo en V o en U disponibles para una escorrenría de fluido optimizada	
Niveles de Fondo	Procesado específicamente para requisitos de impurezas metálicas inferiores a ppb	